

# FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)					電気的特性 (Ta=25°C)										外形	備考	
				V <sub>CB0</sub> (V)	V <sub>CE0</sub> (V)	I <sub>C</sub> (mA)	P <sub>C</sub> (mW)	T <sub>J</sub> (°C)	I <sub>CB0</sub> 最大値 (μA)   V <sub>CE</sub> (V)		直流又はパルスh <sub>FE</sub> V <sub>CE</sub> (V)   I <sub>C</sub> (mA)		バイアス V <sub>CE</sub> (V)   I <sub>B</sub> (mA)		h <sub>FE</sub>	h <sub>ie</sub> h <sub>ie</sub> * (Ω)	h <sub>re</sub> h <sub>re</sub> * (×10 <sup>-4</sup> )	h <sub>oe</sub> h <sub>oe</sub> * (μS)			f <sub>αb</sub> f <sub>αb</sub> * (Mc)
1	2	3	4	5					6		7		8				9	10		11	12

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6 I<sub>CB0</sub> MAXIMUM VALUE AND V<sub>CE</sub> VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I<sub>CB0</sub>)
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h<sub>FE</sub> AND V<sub>CE</sub>, I<sub>C</sub> (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h<sub>FE</sub>)
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V<sub>CE</sub>, I<sub>B</sub> (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

- \* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.
  - 9 f<sub>αb</sub> OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF \* WHICH INDICATES VALUE OF f<sub>T</sub>.
  - 10 C<sub>ob</sub> AND r<sub>bb'</sub> OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF \* IN r<sub>bb'</sub> COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h<sub>ie</sub> (real)
  - 11 OUTLINE
  - 12 REMARKS
- :とコンプリ: COMPLEMENTARY TO .....

www.DataSheet4U.com

www.DataSheet4U.com

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T <sub>a</sub> = 25°C)					電気的特性 (T <sub>a</sub> = 25°C)													外形	備考		
				V <sub>CEO</sub> (V)	V <sub>CEO</sub> (V)	I <sub>C</sub> (mA)	P <sub>C</sub> (mW)	T <sub>J</sub> (°C)	I <sub>CBO</sub> 最大値		直流又はパルス		h <sub>FE</sub>		バイアス		h <sub>FE</sub> *	h <sub>FE</sub> *	h <sub>FE</sub> *	h <sub>FE</sub> *	f <sub>osc</sub> (Mc)			C <sub>ob</sub> (pF)	T <sub>sub</sub> (resl)* (Ω)
									(μA)	V <sub>CE</sub> (V)	V <sub>CE</sub> (V)	I <sub>C</sub> (mA)	V <sub>CE</sub> (V)	I <sub>E</sub> (mA)	h <sub>FE</sub> *	h <sub>FE</sub> *									
2SC1655A	E 電	RF. LN	Si. E	16	3	30	150	175	0.1	10	100	3	10	6	-20	NF < 3dB (8V, 5mA, 500MHz)				8000*	C <sub>ob</sub> 0.5	40*	320		
" 1890A	日立	AF	"	120	5	50	300	125	0.5	100	250-1200	12	2	12	-2					200*	1.5		138		
" 1913A	松下	PA	"	180	5	1A	15W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	100	180	65-330	10	150	10	-50					120*	<10		268		
" 1965A	三菱	"	"	40	4	2A	15W (T <sub>r</sub> =25°C)	175	500	25	50	10	100										97B	ミニア ケース接続	
" 2127A	新電元	SW	Si. T	200	6	10A	100W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	250	200	32	3	10A										102		
" 2128A	"	"	"	200	6	30A	200W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	500	200	22	3	30A										266		
2SC631A	ソニー	RF. AF. LN	Si. E	25	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	C <sub>ob</sub> 350pS	38	2SA704 とコンパリ	
" 632A	"	RF. LN	"	50	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-0.1		36k	2.4	3.3	140*	4.5	C <sub>ob</sub> 350pS	38	2SA705 とコンパリ	
" 633A	"	RF. Conv. Mix Osc. SW	"	25	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-2	t <sub>on</sub> < 60nS, t <sub>off</sub> < 150nS t <sub>rise</sub> < 600nS				140*	4.5	C <sub>ob</sub> 350pS	38	2SA677 とコンパリ	
" 634A	"	"	"	50	6	200	250	120	0.2	25	400	3	1	6	-2	t <sub>on</sub> < 60nS, t <sub>off</sub> < 150nS t <sub>rise</sub> < 600nS				140*	4.5	C <sub>ob</sub> 350pS	38	2SA678 とコンパリ	
" 756A	"	RF. PA	Si. EMe	130	6	4A	10W (T <sub>r</sub> =25°C)	175	1	50	100	2	100	10	-100						100*	45	C <sub>ob</sub> 35pS	181	
" 806A	"	PA	Si. TMe	700	10.5	10A	125W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	5mA	500	40	3	2A	10	-500						5.5*	285	5	102	
" 867A	"	RF. PA	"	520	10	3A	48W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	50	50	80	3	100	10	-200						8.5*	90	12	100	
" 1664A	サンケン	PA	"	100	6	6A	40W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	10	100	1000	4	1A	10	-500						20*	75	12	99	
" 1741A	東洋電機	AF	Si. EP	50	5	500	400	125	0.5	30	82-390	3	100	5	-20						250*	5		138	
" 1871A	日 電	SW	Si. TMe	500	7	10A	100W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	100	400	>15	5	5A			t <sub>on</sub> < 1μS, t <sub>off</sub> < 1μS t <sub>rise</sub> < 2μS								102	
" 2337A	"	PA. SW	Si. E	150	4.5	10A	100W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	50	150	150	5	1A	5	-200	t <sub>on</sub> = 0.2μS, t <sub>off</sub> = 1.8μS t <sub>rise</sub> = 1.5μS				70*	150		102	2SA1007A とコンパリ	
" 2516A	"	SW	"	150	12	5A	30W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	10	80	40-200	5	3A			t <sub>on</sub> < 0.5μS, t <sub>off</sub> < 0.5μS t <sub>rise</sub> < 1.5μS							268	2SA1069A とコンパリ	
" 1627A	東 芝	AF. PA	"	80	5	400	800	150	0.1	50	70-240	2	50	10	-10						100*	10		241	2SA817A とコンパリ
" 1708A	三 菱	AF. IN. RF	Si. EP	120	5	50	200	125	0.1	70	250-1200	6	1	6	-1	V <sub>NO</sub> < 170mV (10V, 1mA, I <sub>0</sub> = 100kΩ, A <sub>v</sub> = 80dB)					150*	1.8		138B	2SA847A とコンパリ
" 1914A	"	AF. RF	"	120	5	50	200	125	0.1	70	250-1200	6	1	6	-1						150*	1.8		138B	
" 2126A	新電元	SW	Si. T	200	6	3A	30W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	250	200	42	3	3A			t <sub>on</sub> < 1μS, t <sub>off</sub> < 1μS t <sub>rise</sub> < 2μS								204	
" 2139A	東 芝	"	"	500	6	10A	100W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	100	400	>20	5	5A			t <sub>on</sub> < 1μS, t <sub>off</sub> < 1μS t <sub>rise</sub> < 2.5μS								102	
" 2230A	"	PA	"	200	5	100	800	150	0.1	200	120-400	10	10	10	-10						>50*	<7		241	
" 2231A	"	"	"	200	5	200	12W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	0.1	200	100-320	10	50	10	-50						>50*	<10		178	
" 2238A	"	"	Si. E	180	5	1.5A	25W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	1	160	70-240	5	100	10	-100						100*	25		268	2SA968A とコンパリ
" 2238B	"	"	"	200	5	1.5A	25W (T <sub>r</sub> =25°C)	150	1	160	70-240	5	100	10	-100						100*	25		268	2SA968B とコンパリ